

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 57-132357

(43)Date of publication of application : 16.08.1982

(51)Int.Cl.

H01L 29/72

H01L 29/80

(21)Application number : 56-017478

(71)Applicant : OKI ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 10.02.1981

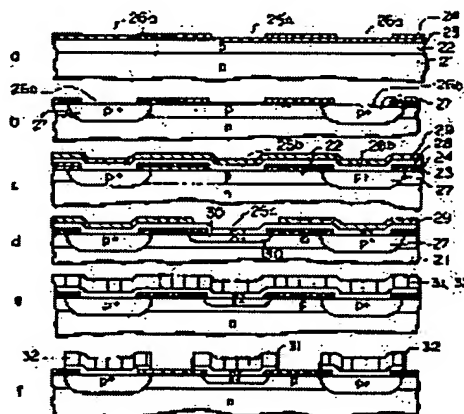
(72)Inventor : SANO YOSHIAKI
NONAKA TOSHIO

(54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR ELEMENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the deterioration of withstand voltage due to the slip of a mask for the subject semiconductor element by a method wherein a polysilicon layer is formed on the semiconductor substrate on which an insulating film with two windows was formed and polysilicon electrodes are formed by ion implantation and diffusion.

CONSTITUTION: An N type silicon oxide film 23 and a silicon nitride film 24 are formed on the N type silicon substrate 21 whereon a P type base region 22 was formed, and two windows 25a and 26a are provided on the silicon nitride film 24. Then, a window 26a is opened on the silicon oxide film 23, and a side base region 27 is formed by performing boron diffusion. After a window 25b has been opened on the silicon oxide film 23, a non-doped polysilicon layer 28 and a silicon nitride film 29 are formed. A window 25c is opened on the film 29, and N type impurities are injected in the polysilicon layer 28 using the film 29 as a mask. A heat treatment is performed and an emitter region 30 is formed by diffusing N type impurities, and at the same time, boron is diffused on the polysilicon layer 28 on the region 27 using the side base region 27 as a source of diffusion.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision]

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑬ 日本国特許庁 (JP)

⑭ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—132357

① Int. Cl.³
H 01 L 29/72
29/80

識別記号

庁内整理番号
7514—5F
7925—5F

⑬ 公開 昭和57年(1982)8月16日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑭ 半導体素子の製造方法

① 特 願 昭56—17478

② 出 願 昭56(1981)2月10日

③ 発 明 者 佐野芳明
東京都港区虎ノ門1丁目7番12
号沖電気工業株式会社内

④ 発 明 者 野中敏夫

東京都港区虎ノ門1丁目7番12
号沖電気工業株式会社内

⑤ 出 願 人 沖電気工業株式会社
東京都港区虎ノ門1丁目7番12
号

⑥ 代 理 人 弁理士 鈴木敏明

明 細 書

1. 発明の名称

半導体素子の製造方法

2. 特許請求の範囲

第1伝導形の表面層(22, 27)を有する半導体基体(21)上に、第1窓(25b)及び第2窓(26b)を有する第1絶縁膜(23, 24)が形成されたものを用意する段階と、その後全面にノンドープのポリシリコン層(28)を形成し、更に、その上にイオン注入マスク材質の第2絶縁膜(29)を形成する段階と、この第2絶縁膜(29)の第2窓相当部に窓(25c)を開けた後、この第2絶縁膜(29)をマスクとして第2伝導形不純物を前記ポリシリコン層(28)へイオン注入する段階と、このポリシリコン層(28)の前記第2伝導形不純物を熱拡散して前記第1伝導形表面層内に第2伝導形領域(30)を形成させ、同時に前記第1伝導形表面層(27)の第1伝導形不純物を前記ポリシリコン層(28)へ熱拡散させる熱処理段階と、を備えていることを特

徴とした半導体素子の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、半導体素子の製造方法に関し、特にマイクロ波バイポーラトランジスタや接合電界効果トランジスタに適用して有用な製造方法に関する。

この種の製造方法においては、マスクパターンは一般に微細であり、マスク合わせの時のマスクずれによって素子の特性及び信頼性に大きな影響を及ぼし、そこでマスク合わせによって特性が左右されない製造方法が必要とされている。

従来のトランジスタの製造方法を第1図によって説明する。まず、コレクタ領域であるシリコンウエハ11上のメインベース領域12とシリコン酸化膜13とを形成後、サイドベース拡散の窓14をあける(第1図a)。次に、ボロンを拡散してサイドベース領域15を形成してからエミッタ拡散の窓16をあける(第1図b)。続いてリンあるいは砒素を拡散してエミッタ領域17を形成した後、サイドベース領域15上及びエミッタ領

域17上にコンタクトの窓18をあける(第1図c)。最後に、メタルのリフトオフを行ってエミッタ電極19a及びベース電極19bを形成する(第1図d)。

このように従来の製造方法では、エミッタ領域17とサイドベース領域15との配置がマスク合わせの精度によって決定され、マスクずれによるエミッタベース間のキャパシタンスの増大、逆方向耐圧の減少という欠点があった。又、コンタクト窓あけのマスクずれによっても耐圧の劣化や歩留りの減少になる。又、電極金属19a, 19bが接合に近く被着されるため、金属マイクレーションによって接合が汚染され、耐圧の劣化や歩留りが減少する危険があった。

本発明の目的は、これらの欠点を除去することとあり、電極としてポリシリコンを介在させたものであって、まず第1伝導形の表面層を有する半導体基体の表面に第1窓と第2窓とを有する第1絶縁膜が形成されたものを用意し、その全面にノンドープのポリシリコン層を形成し、次いで比較

的粗いマスクを用い、且つ、イオン注入によって第2窓対応部のポリシリコン層に第2伝導形不純物を注入し、熱処理によって第2窓対応部の第1伝導形層内に第2伝導形領域を形成させると同時に、第1窓相当部のポリシリコン層を第1伝導形不純物のポリシリコン電極とするものであり、以下詳細に説明する。

第2図は本発明の実施例を説明するものであって、マイクロ波バイポーラトランジスタの例である。まず、コレクタとなるn形のシリコンウエハ21にp形のメインベース領域22を形成後、シリコン酸化膜23及びシリコン窒化膜24をCVD法によって形成し、ホトリソ(またはプラズマエッチング)によってエミッタ領域とサイドベース領域とに相当する位置のシリコン窒化膜24にそれぞれ窓25a, 25bを開ける(第2図a)。

次に、シリコン窒化膜24の窓25をレジスト(図示せず)でカバーしてから、レジスト及びシリコン窒化膜24をマスクとしてシリコン酸化膜23をエッチングして、サイドベース拡散の窓26b

をあけ、更にボロンを拡散して、メインベース領域12と同一伝導形で高濃度のサイドベース領域27を形成する(第2図b)。この段階では正確なマスク合わせは必要ない。

次に、シリコン窒化膜24をマスクとしてシリコン酸化膜23をエッチングしてエミッタ拡散の窓25bをあけてから、全面にCVD法によってノンドープのポリシリコン層28及びシリコン窒化膜29を連続的に形成する(第2図c)。

次に、ホトリソによってシリコン窒化膜29にエミッタ拡散の窓25bをカバーする窓25cを開け、シリコン窒化膜29をマスクとしてポリシリコン28に砒素(あるいはリン等)のn形不純物のイオン注入を行う。次に熱処理を行って、イオン注入されたポリシリコン28を拡散源としてシリコンウエハ21にn形不純物を拡散してエミッタ領域30を形成する。又、同時に、この熱処理において、シリコン窒化膜29をウエハ外部への拡散のマスクとして、サイドベース拡散の窓26bを通して、サイドベース領域27を拡散源として、

サイドベース領域27上のポリシリコン層28にボロンを拡散する(第2図d)。この段階でも正確なマスク合わせは必要でない。次にシリコン窒化膜29を除去した後メタルの全面蒸着を行う(第2図e)。

次に、ホトリソによってマスクを形成した後、イオンエッチング法によってパターン化してエミッタ電極31及びベース電極32を形成し、さらに連続的にポリシリコン28のプラズマエッチングを行って各電極を分離する(第2図f)。

以下説明したように、この実施例では本質的には、粗いマスク合わせは必要だが、第2図9で示す工程においてエミッタ及びサイドベース領域を一回のホトリソで位置決めしているのみなので、マスクずれによるエミッタ、ベース間の耐圧の減少、キャパシタンスの増大の恐れがない。又、第2図c~eの工程で示すように、エミッタ領域30においてポリシリコン28からシリコンウエハ側21, 22への不純物の拡散と同時に、サイドベース領域27においてシリコンウエハ側21, 22

からポリシリコン層28への不純物の拡散を行っているため、1回のポリシリコンCVDにおいて、エミッタまたはサイドベース領域27, 30上に対応して異なる伝導型を有するポリシリコン層を形成することができる。このため、n型のポリシリコン、p型のポリシリコンをCVD法や拡散によって各々形成する必要がない利点がある。又、第2図に示すように、電極メタル31, 32をエッチングによってパターン化しているので、蒸着の時にシフトオフ法のようにレジストを必要としないため、厚くメタル形成でき、又、蒸着前に高圧のウエハ加熱を行えることによってオーミック特性を向上させることができる。又、イオンエッチングをポリシリコン層の一部まで行うことによりメタルの分離を確実に行うことができ、残ったポリシリコンを連続的にプラズマエッチングを行って電極の分離を行うことができる。このように、各電極メタルはポリシリコンを介してシリコンウエハに接触しているため、マイグレーションによって接合を汚染する危険が少なく、又、ポリシリ

コンとメタルがセルフアライン化されているので、微細な電極パターンを形成することができる。

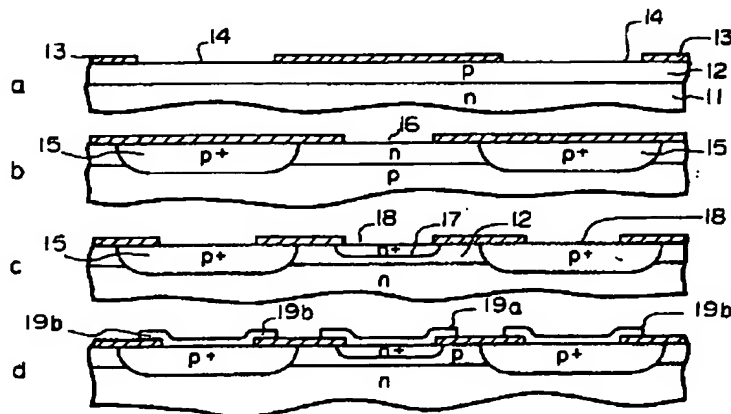
以上の如く、本発明は、微細加工を必要とする高信頼性の半導体素子において、ベース及びエミッタ等上に、それぞれ対応する伝導型をもつポリシリコンを介した電極をセルフアライン的に形成できるため、電極を微細で信頼が高く構成できる利点があり、マイクロ波バイポーラトランジスタや接合電界効果等の製造方法に利用することができる。

4. 図面の簡単な説明

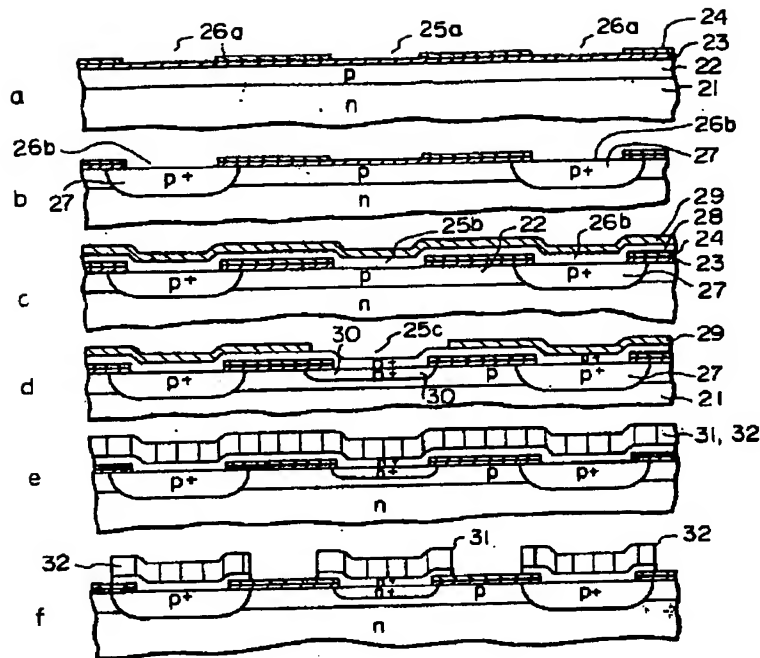
第1図は従来の半導体素子の製造方法を示す断面図、第2図は本発明の一実施例を説明する断面図である。

21…シリコンウエハ、22…メインベース領域、23…シリコン酸化膜、24…シリコン窒化膜、25a, 25b, 26a, 26b, 26c…窓、27…サイドベース領域、28…ポリシリコン、29…シリコン窒化膜、30…エミッタ領域、31…エミッタ電極、32…ベース電極。

第1図



第2図



手続補正書(自発)

昭和56年5月15日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

昭和56年 特 許 願第 017478号

2. 発明の名称

半 導 体 素 子 の 製 造 方 法

3. 補正をする者

事件との関係

特 許 出 願 人

住 所(〒105) 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

名 称(029) 沖 電 気 工 業 株 式 有 限 公 司

代表者 取締役社長 三 宅 正 男

4. 代 理 人

居 所(〒105) 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

沖 電 気 工 業 株 式 有 限 公 司 内

氏 名(6892) 弁 理 士 鈴 木 敏 明

電 話 501-3111(大代表)

5. 補正の対象 明細書中「発明の詳細な説明」の欄

6. 補正の内容 別紙のとおり

6. 補正の内容

- (1) 明細書第3頁第12行に「マイク」とあるのを「マイグ」と補正する。
- (2) 同書第5頁第4行に「必要ない。」とあるのを「必要でない。」と補正する。
- (3) 同書第7頁第10行に「シフト」とあるのを「リフト」と補正する。